双频塞曼 He Ne 激光 $g^{(1)}(T)$ 的时谱特性及其可能应用

浦兆明

印建平 高伟建

(南京医科大学物理教研室,南京,210029) (苏州大学物理系,苏州,215006)

摘要:本文从塞曼激光器典型的频谱结构出发,导出了双频塞曼 He Ne 激光时间相干度 $g^{(1)}$ (T) 在纵模频率漂移效应作用下的时谱公式,分析了相应的时谱特性和频率调谐特性,并在此基础 上探讨了 $g^{(1)}$ (T)时谱特性在某些激光参数测量中的可能应用。

关键词:双频塞曼激光 时间相干性 $g^{(1)}(\tau)$ 时谱特性 稳频稳幅

Time-spectrum characteristics of $g^{(1)}(\tau)$ of double frequency Zeemen He-Ne laser and its applications

Pu ZhaomingYin Jianping, Gao Weijian(Department of Physics, Nanjing Medical University)(Department of Physics, Suzhou University)

Abstract: In terms of the typical structure in frequency spectrum of Zeemen He-Ne laser, a timespectrum formula $g^{(1)}(\tau)$ (the degree of first order temporal coherence) of the double frequency Zeemen laser is derived, considering of the longitudinal mode frequency drift. These research results show that: (1) because of the effect of line width, the time coherence $g^{(1)}(\tau)$ has the variation of period $\tau_0 =$ $1/\Delta V_{dr}$, (2) the variation of time spectrum of $g^{(1)}(\tau)$ is relative to frequency drift of double frequency mode; (3) the time spectrum characteristics of $g^{(1)}(\tau)$ can be used in the measurements of the laser parameters or the frequency stabilization of the double frequency lasers.

Key words: double frequency Zeemen laser temporal coherence time-spectrum property of $g^{(1)}$ (τ) frequency and power stabilization



双频塞曼激光器是一种利用光学塞曼效应和拍频原理研制而成的新颖激光光源,目前已 被广泛应用于双频激光干涉仪,相干光通讯^[1],高分辨率激光光谱学及其光学频标^[2]之中。

近年来,国内外许多学者开展了双频塞曼激光稳频稳幅的理论与实验研究^[3~9],相应的 稳频方法主要有功率调谐稳频法^[4]和拍频调谐稳频方法^[3,7~9]。前者是利用塞曼分裂的左旋 和右旋圆偏振光的功率调谐特性(也即左、右旋光的强度)实现稳频的,其稳频精度一般为 10^{-9} 量级,再现性为 10^{-7} 量级,后者是利用双频塞曼激光的拍频调谐特性(也即左、右旋光的 频率差)来实现稳频的,其稳频精度通常可达 10^{-11} 量级,再现性达 10^{-9} 量级。在拍频调谐稳 频法中又可分为纵向塞曼激光拍频稳频法^[5,6]、横向塞曼激光拍频稳频法^[3,7]和偏频锁定稳频 法^[8]以及反馈控制激光等离子体折射率的稳频方法^[9]等。本文重点分析了双频塞曼激光时 间相干度 $g^{(1)}(\tau)$ 的时谱特性和频率调谐特性,探讨了 $g^{(1)}(\tau)$ 时谱特性在双频塞曼激光某些 参数测量中的可能应用。

二、时谱公式推导

激光**双频塞曼 He Me:激光典型的频谱结构如图**1所示。图中 V_0 为单模激光中心频率, $V_{dL}(t)$

浦兆明反双频塞曼印eN書激光室(寸(ጚ)的时谱特性及其可能应用 http://www.jgjs.net.cn



Fig. 1 Frequency spectrum structure of the double frequency Zeemen He Ne laser

和 $V_{qR}(t)$ 分别为 t 时刻左、右旋光的频率位置, V_{oL} 和 ΔV_{oR} 分别为左、右旋光增益曲线 $g_{D}(V - V_{oL})$ 和 $g_{D}(V - V_{oR})$ 的中心频率, ΔV_{D} 为增益线宽, δV_{H} 为单 频模频宽, 相应的单频模线型为 Lorentz 线型函数, 增益曲线为 Gauss 线型函数; ΔV_{oLR} 和 ΔV_{R} 分别为塞 曼裂距和左、右旋光的频率差(拍频值), $\Delta V(t)$ 为双 频 $V_{qL}(t)$, $V_{qR}(t)$ 相对于频率对称点($V_{0} \pm \Delta V_{LR}/2$) 的频率漂移量。

295

(2)

4)

(9)

 $\mathcal{V}(t)$

 $(\nu - \nu_{oR})$, 单频模线型函数为 $g_{H}(\nu)$, 且假定 $\Delta \nu_{oLR}$, $\Delta \nu_{LR}$ 和 $\Delta \nu_{D}$ 不随时间而漂移, 或漂移很小, 以致于可忽略不计, 则双频塞曼激光 He Ne 激光器的功率谱密度可表示为

$$W(\mathcal{V}) = \left[\delta_{1}(\mathcal{V}) g_{D}(\mathcal{V} - \mathcal{V}_{0R}) + \delta_{2}(\mathcal{V}) g_{D}(\mathcal{V} - \mathcal{V}_{0L}) \right] \times g_{H}(\mathcal{V})$$
(1)

$$\vec{\tau}$$
, $\vec{\mu}$ $\delta_{\nu}(\nu) = \delta_{\nu} - \nu_{eB} + (\Delta \nu_{eB} - \Delta \nu_{eB})/2 + \lambda_{eB}$

$$\delta_{2}(\mathcal{V}) = \delta \mathcal{V}_{-} \mathcal{V}_{oL} - (\Delta \mathcal{V}_{oLR} - \Delta \mathcal{V}_{LR})/2 + \Delta \mathcal{V}(t)$$

$$\mathcal{V}_{oLR} = \mathcal{V}_{oL} - \mathcal{V}_{oR} = 2g(\mu_B H / h)$$

$$\Delta \mathcal{V}_{LR} = \mathcal{V}_{qL} - \mathcal{V}_{qR} = \frac{\ln 2}{\pi} 4g \mu_B H / h (\Delta \mathcal{V}_o / \Delta \mathcal{V}_D)$$
(3)

以及

$$g_{n}(\mathcal{V}) = (1/2\pi) \{ \delta \mathcal{V}_{\rm H} / [\mathcal{V}^{2} + (\delta \mathcal{V}_{\rm H}/2)^{2}] \}$$

 $g_{\rm D}(\mathcal{V}-\mathcal{V}_{\rm oLR})_{\rm LR} = \ln 2/\pi (2/\Delta \mathcal{V}_{\rm D}) \exp - \ln 2 (\mathcal{V}-\mathcal{V}_{\rm oLR})/\Delta \mathcal{V}_{\rm D}^{-3}$

g 为朗德因子, 对于 632. 8nm 线, g=1.3, μ_B 为玻尔磁子, H 为磁场强度, h 为普朗克常数, ΔV_c 为无源腔单模线宽, c 为真空中的光速, L 为激光器腔长, T 为腔镜的透过率, α 为谐振腔的单程损耗。

根据时间相干度的定义和 Wiener-Kintchine 定理

Ι

$$g^{(1)}(\tau) = G^{(1)}(\tau) / G^{(1)}(0)$$
(5)

$$G^{(1)}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} W(\nu) \exp(-j 2\pi \nu \tau) \,\mathrm{d}\nu$$
(6)

以及卷积定理,得到自由运转双频塞曼 He Ne 激光场 $g^{(1)}$ (\mathfrak{T})的时谱公式为

 $|g^{(1)}(\tau, t)| = \exp(-a\tau) |I_{21}^{2}(t) + I_{22}^{2}(t) + 2I_{21}(t)I_{22}(t)\cos(2\pi\Delta V_{LR}\tau)|^{1/2}$ (7) 式中, $I_{21}(t)$ 和 $I_{22}(t)$ 分别为双频模输出的相对强度,由下式给出

$$I_{21}(t) = \exp - (\pi^2/4b^2) \left[\Delta \mathcal{V}_{0LR} - \Delta \mathcal{V}_{LR} + 2\Delta \mathcal{V}(t) \right]^3 I(t)$$
(8)

$$22(t) = \exp \left[- \left(\frac{\pi^2}{4b^2} \right) \left[\Delta \mathcal{V}_{0LR} - \Delta \mathcal{V}_{LR} - 2\Delta \mathcal{V}(t) \right]^2 I(t)$$

而

$$a = \pi \delta \Delta V_H$$
 $b = \pi \Delta V_D / (2 \ln 2)$

三、时 谱 分 析

令 T_0 = 1/ △ V_{LR} 为双频激光的特征时间, 且设 $T_{=}$ mT_0 , 或(m + 1/2) T_0 则由(7) 式分别得 到时延量 T_0 **万**@的整数倍, 或半整数倍处的时间相干度 版权所克 © 技激光技术》编辑部

http://www.jgjs.net.cn

$$|g^{(1)}(0, mT_0)| = \exp(-maT_0)$$

和 $|g^{(1)}[t, (m + 1/2) T_0]| = \exp[-(m + 1/2) a T_0] | I_{21}(t) - I_{22}(t)|$ (11) 当单模线宽 $\delta_{H}^{\rightarrow} 0, \vec{u}, \vec{a} T \ll 1$ 时,上述两式可改写为

$$|g^{(1)}(0, m \tau_0)| = 1$$
 (12)

$$g^{(1)}[t, (m + 1/2) \mathsf{T}_0] = |I_1(t) - I_2(t)| / |I_1(t) + I_2(t)|$$
(13)

I

$$I_2(t) = I_0 \exp \left[- \left(\frac{\pi^2}{4b^2} \right) \left[\Delta \mathcal{V}_{0LR} - \Delta \mathcal{V}_{LR} + 2\Delta \mathcal{V}(t) \right]^2 \right]$$

 $I_1(t) = I_0 \exp \left[- \left(\frac{\pi^3}{4b^2} \right) \left[\Delta \mathcal{V}_{0LR} - \Delta \mathcal{V}_{LR} + 2\Delta \mathcal{V}(t) \right]^2 \right]$

相应的双频模相对强度 $k(t) = I_1(t)/I_2(t)$ 由下式给出

$$k(t) = \exp \left(2\pi^3 / b^2\right) \left[\Delta \mathcal{V}_{0LR} - \Delta \mathcal{V}_{LR} + \Delta \mathcal{V}(t)\right]$$
(15)

通常, 对于 632. 8nm 线的双频塞曼 HeNe 激光器, 当腔长为 *L* = 15cm, 磁场强度 *H* 在 300G 以内时, $\Delta V_{LR} \approx 0.1 \sim 1$ MHz, 相应的塞曼裂距 $\Delta V_{0LR} \approx 100 \sim 1000$ MHz(与腔稳定因子 $\sigma_0 = 0.94 \Delta V_c / \Delta V_b$ 有关), 特征时间 $T_0 \approx 10^{-6} \sim 10^{-8}$ s。设 $\Delta V_{D} = 800$ MHz, $\Delta V_{LR} = 0.4$ MHz($T_0 = 2.5 \times 10^{-6}$ s), $\Delta V_{0LR} = 400$ MHz($\sigma_0 \approx 10^{-3}$), 则当频率漂移量 $\Delta V(t)$ 从 – $\Delta V_D/2$ 单方向漂移 至 $\Delta V_D/2$ 时, 由(7) ~ (9) 式计算得到 T = 0, $T_0/6$, $T_0/3$, $T_0/2$, 及 2 $T_0/3$, 5 $T_0/6$ 和 T_0 处的 $g^{(1)}$ (7) 时谱特性曲线, 或当 $\Delta V(t) = -\Delta V_D/2$, $-\Delta V_D/4$, 0, $\Delta V_D/4$ 和 $\Delta V_D/2$ 时, $g^{(1)}$ (T) 随时延量 T 而变化的曲线, 如图 2a 和 b 所示。



b—relation of $g^{(1)}(\tau)$ to time delay τ

由上述理论分析不难看 出,双频塞曼激光 g⁽¹⁾(^T)具 有如下时谱特性:

1. 对于给定的频率漂移 量 $\Delta V(t)$,双频塞曼激光的时 间相干性 $g^{(1)}(T)$ 随时延量 T (或光程差 $\Delta l = cT$)呈现出周 期性的变化,其周期即为特征 时间 $T_0 = 1/\Delta V_{LR}$ 。当 $\Delta V_{LR} =$ 0.4MHz时,与 T_0 相应的光程 差周期 $\Delta lo = 750$ m。

2. 当时延量 T 为周期 T₀ 的整数倍(即 T= mT₀)时, $g^{(1)}$ (T) = 1, 或 exp(- maT₀), 与双频 模频率漂移量 $\Delta V(t)$ 无关; 而当 T= (m + 1/2) T₀ 时, $0 \leq g^{(1)}$ (T, t) ≤ 1 , 与双频率漂移 $\Delta V(t)$ 有 关, 且在所有的时空点上, T= (m + 1/2) T₀ 处最能有效地反映双频模频率漂移效应 $\Delta V(t)$ (尤 其是 m = 0 处)。

3. 当 $T = (m + 1/2) T_0$ 时,双频激光场的 $g^{(1)}(T)$ 不仅与频率漂移量 $\Delta V(t)$ 有关,而且还 与激光线宽 ΔV_D ,塞曼裂距 ΔV_{oLR} 和双频激光的拍频值 ΔV_{LR} 有关,因而这表明利用双频塞曼激 光 $g^{(1)}(T)$ 的时谱特性不仅可实现稳频稳幅,而且还可用来测量 ΔV_D ,或 ΔV_{oLR} 或 ΔV_{LR} 。

4. 此外,在 T= (m + 1/2) To 处,双频塞曼激光场的时谱特性呈现出" V" 曲线,仅当 $\Delta V(t)$ = 0,也即双频输出强度相等[k(t) = 1]时, $g^{(1)}(T)$ = 0。

激光技术 jgjs@sina.com

(10)

(14)

http://www.jgjs.net.cn

四、应 用 探 讨



(T)的频率调谐公式。当调 谐量为 $\Delta V = \pm \Delta V_0 / 2$ (单向 线性调谐)时,由(16)式计算 得到相应的频率调谐特性曲 线,如图 3 所示。其中图 3a 的计算参数为 ΔVLR = 0. 4MHz, $\Delta \mathcal{V}_{oLR} = 400 \text{MHz}$, $\Delta v_0 = 700 M Hz$, 800 M Hz 和 900MHz; 图 3b 的参数为

此式即为双频塞曼 He

Fig. 3 Frequency tuning feature curves of $g^{(1)}(\tau)$ in a double frequency Zeemen He Nelaser

 $\Delta V_{LR} = 0.4 \text{ MH z}, \ \Delta V_{D} = 800 \text{ MHz}, \ \Delta V_{oLR} = 200 \text{ MHz}, 400 \text{ MHz}, B 600 \text{ MHz}_{o}$

由图 3 可知: 当给定激光参数 ΔV_{AB} 和 ΔV_{B} 时, 不同的激光线宽 ΔV_{D} 对应着不同的频率调 谐特性曲线: 同样当已知激光线宽 ΔVo 和拍频值 ΔVcR时, 不同的寒曼裂距 ΔVcLR对应着不同的 频率调谐特性曲线。因此,如果用锯齿波电压驱动连接于激光谐振腔某一腔镜上的压电陶瓷 PZT, 使激光频率被单向线性调谐, 并采用光纤迈克尔逊干涉仪实时测得 $g^{(1)}$ (T) 的频率调谐 特性曲线, 即可在已知(或由其他方法测得)激光参数 ΔVoLR和 ΔVLR的条件下由(16)式求得激 光线宽 ΔV_{D} , 或在已知 ΔV_{0} , ΔV_{0LR} 时求得 ΔV_{LR} , 或在已知 ΔV_{LR} 时求得 ΔV_{0LR}

此外, 由(16) 式或图 3 知, 原理上 $g^{(1)}(T)$ 的时谱特性也可用于双频塞曼激光器的稳频稳 幅,其稳频原理类似于纵向塞曼拍频稳频法^[5,6]和双纵模激光的干涉稳频法^[10]。

五、结 论

我们根据双频塞曼激光器典型的频谱结构, 导出了自由运转状态下双频塞曼 He Ne 激光 时间相干度 $g^{(1)}(\tau)$ 的时谱公式, 分析了相应的 $g^{(1)}(\tau)$ 时谱特性和频率调谐特性。研究发 现: 1. 考虑到单频模线宽 $\delta v_{\rm H}$ 的影响, 双频塞曼激光的时间相干性 $g^{(1)}$ (T) 呈现出准周期变化 的特点,其周期为 $T_{0}=1/\Delta V_{oLR}$; 2. 除 $T=mT_0$ 处外,自由运转双频激光 $g^{(1)}(T)$ 的时谱变化与 双频模的频率漂移效应 $\Delta \mathcal{V}(t)$ 有关,且在 T= (m+1/2) T₀ 处,其 $g^{(1)}(T)$ 的时谱变化最大,最 能有效地反映双频模的频率漂移量 $\Delta V(t)$ (尤其在 m = 0 处); 3. 双频激光 $g^{(1)}(\tau)$ 的时谱特 性可用于双频激光参数(ΔV_D , 或 ΔV_{LR} , 或 ΔV_{oLR}) 的测量, 原理上也可用于双频激光器的稳频 稳幅。 考文 献

(16)

¹ Wyatt R, Hodgkinson T G. Electron Lett, 1983; 19(14): 550

[,] Å²° ¿ . ³ ± Ä ½¶¼Ä , 1984; 6(4) : 1084 2 ±ÃÀ³

³ Umeda N, Tsukiji M, Takasaki H. Appl Opt, 1980; 19(3): 442

清华大学双频激光组.物理.1976;5(2):80

激光搪森在T, j K j w 编版 IP W, CH III J L. Appl Opt, 1980; 19(18): 3173

版权廠有 ©光《激光技术》术编辑部 LASER TECHNOLOGY

Vol. 20, No. 5 October, 1996

电调频半导体激光绝对测量干涉仪*

武勇军 李达成

(清华大学精仪系,北京,100084)

摘要:分析了电调频半导体激光干涉仪的长度绝对测量原理,介绍了干涉仪的基本结构。实验结果表明,该干涉仪的绝对测量范围为 0.3~1.5m,测量误差为 0.1~0.3mm。

关键词: 绝对测量 调频 干涉仪 半导体激光器

A interferometer for absolute distance measurement using diode laser with current-induced frequency modulation

Wu Yongjun, Li Dacheng (Dept. of Precision Instruments, Tsinghua University)

Abstract: The principle of absolute distance measurement using a diode laser with current- induced frequency modulation is presented. The configuration of the interferometer is described. The experimental results show that the measurable range of the interferometer is 0.3 to 1.5 meter with accuracy of 0.1 to 0.3 mm.

Key words: absolute measurement interferometer frequency modulation diode laser

一、引言

半导体激光器不仅体积小,寿命长,能量转换效率高,而且具有很好的频率调制特性。改 变它的注入电流强度,就可以改变其光频率,而且当注入电流强度低频变化(< 10kHz)时,激 光频率随注入电流强度变化而线性变化^[1]。本文将半导体激光器的这种线性调频特性用于 长度的绝对测量,研制出绝对测量干涉仪,实现了1.5m 范围内的长度绝对测量。

* 国家教委博士点基金资助。

6 王 楚, 沈伯弘, 吴文芳.光学学报, 1984; 4(9): 808

7 巴恩旭, 杨性愉, 刘玉照 et al. 光学学报, 1984; 4(5): 398

8 廖世强,赵家铭,王育竹.激光杂志,1988;9(4):215

9 谢 毅, 张小平. 中国激光, 1991; 18(4):251

10 印建平. 中国激光, 1989; 16(10): 621



作者简介: 浦兆明(附照片), 男, 1954 年 10 月出生。室副主任, 讲师。近年来主要从事激光物 理与技术, 量子光学及激光生命科学等方面的科研工作。

印建平, 男, 1955 年 10 月出生。硕士, 教授。长期从事激光物理、光谱学和量子光学等方面的 教学与科研工作。

收稿日期: 1995-05-10 收到修改稿日期: 1995-10-15

激光技术 jgjs@sina.com